

高效单晶硅单面半片太阳能组件

RS9-650~670M-E1

P型 / 正功率公差为0~+3%/最高效率 21.60%

- 适配超大型地面电站和分布式项目
- 先进技术提升组件功率、效率
 - 掺镓硅片 · 无损切割 · 多主栅半片
- 高发电性能
 - 优异的IAM及弱光响应 · 低温度系数 · 0.45%线性功率衰减
- 高品质保证组件长期可靠性
 - 严选材料 · 先进工艺 · 领先标准
- 超亲水自清洁镀膜技术



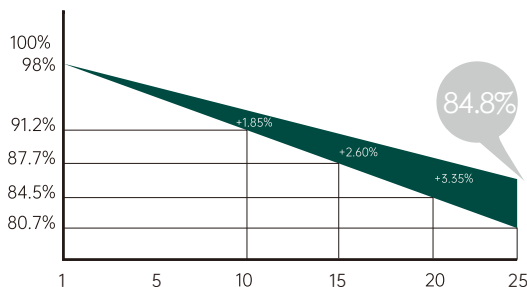
完整的质量管理体系
与产品认证IEC

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015:质量管理体系

ISO14001:2015:环境管理体系

ISO45001:2018:职业健康安全管理体系

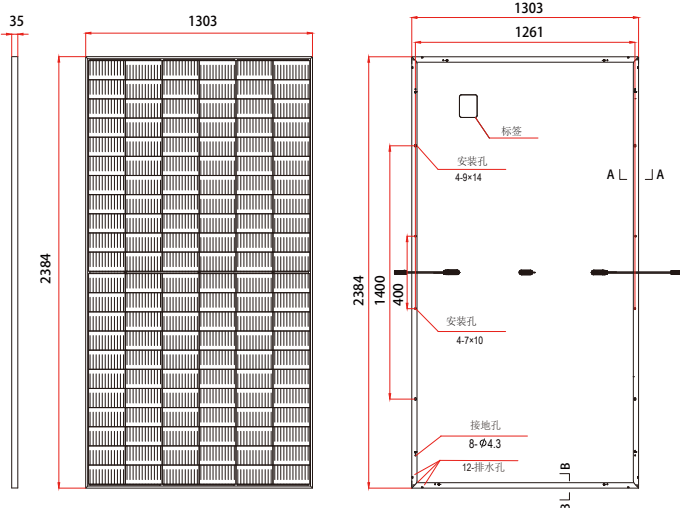


25年超额线性功率输出质保

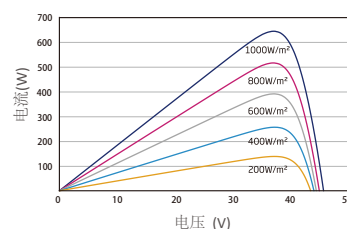
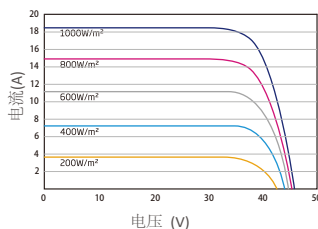


RS9-650~670M-E1

高效单晶硅单面半片太阳能组件



图纸仅供参考



电气特性STC	RS9-650M-E1	RS9-655M-E1	RS9-660M-E1	RS9-665M-E1	RS9-670M-E1
峰值功率 (Pmax)	650W	655W	660W	665W	670W
功率公差	0~+5W	0~+5W	0~+5W	0~+5W	0~+5W
组件效率	20.90%	21.10%	21.20%	21.40%	21.60%
峰值电流 (Imp)	17.39A	17.43A	17.47A	17.51A	17.55A
峰值电压 (Vmp)	37.40V	37.60V	37.80V	38.00V	38.20V
短路电流 (Isc)	18.44A	18.48A	18.53A	18.57A	18.62A
开路电压 (Voc)	45.30V	45.5V	45.70V	45.90V	46.10V

STC: 辐照度 1000W/m² 电池温度 25°C AM=1.5

电气特性NOCT	RS9-650M-E1	RS9-655M-E1	RS9-660M-E1	RS9-665M-E1	RS9-670M-E1
峰值功率 (Pmax)	492W	496W	500W	504W	508W
峰值电流 (Imp)	14.09A	14.13A	14.17A	14.22A	14.26A
峰值电压 (Vmp)	34.90V	35.10V	35.30V	35.40V	35.60V
短路电流 (Isc)	14.86A	14.89A	14.93A	14.96A	15.01A
开路电压 (Voc)	42.70V	42.90V	43.00V	43.20V	43.40V

NOCT: 辐照度 800W/m² 环境温度 20°C AM=1.5 风速 1m/s

结构特性

电池片	高效P型单晶 210×210 (±1) mm, 132(6×22), 半片电池
玻璃	3.2mm, 高透光率, 低铁, 钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68防护等级, 旁路二极管
尺寸	2384×1303×35mm
输出电缆	4 mm ² (EU), 300 mm
重量	33.5 kg
安装孔位置	见参考图

包装信息

平板车	13m/17.5m平板车
托盘	18/27托
片	558/837片

温度系数

开路电压 (Voc) 温度系数	-0.27%/°C
短路电流 (Isc) 温度系数	+0.04%/°C
峰值功率 (Pmax) 温度系数	-0.35%/°C
标称电池工作温度 (NOCT)	45°C ± 2°C

注: 本目录中的电气数据不是指单个模块, 它们不是报价的一部分。它们只用于不同模块类型之间的比较。

产品容限

工作温度	-40°C ~ +85°C
最大系统电压	1500VDC
最大串联熔断电流	35A

